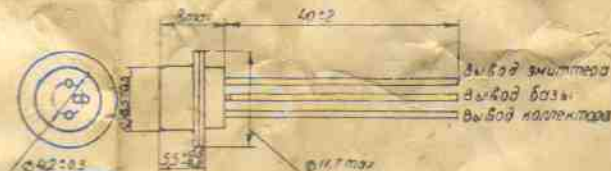




РСФСР

Транзисторы германиевые плоскостные р-п-р типов
МП16, МП16А, МП16Б (СБ0.336.008 ТУ1)



Электрические параметры транзисторов при температуре окружающей среды $+20 \pm 5^\circ\text{C}$

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	Обозначение	Единица измерения	Нормы электрических параметров						Режим испытаний					
			МП16		МП16А		МП16Б		I _к	U _к	U _б	I _э	I _с	
			не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более						ма
Коэффициент усиления по току	β		20	35	30	50	45	100	10	-1				
Ток закрытого транзистора (импульсный)	I _{кз}	мкА		400		400		400		-12				
Ток закрытого транзистора (статический)	I _{кз}	мкА		25		25		25		-15	+0,5			
Предельная частота усиления по току	f _а	МГц	1,0		1,0		2,0		-5			1		
Время переключения (при насыщении, сопротивлении в цепи коллектора 1,5 ком и входном импульсе минус 12 в длительностью 10 мксек)	τ	мксек		2,0		1,5		1,0		-15				
Остаточное напряжение	U _{к0}	в		0,1		0,15		0,2	10					1
Входное напряжение	U _{вх}	в		0,3		0,35		0,4	10					1

Предельно-допустимые эксплуатационные данные

Мощность, рассеиваемая транзистором, при температуре окружающей среды до плюс 45°C

200 мвт.

Мощность, рассеиваемая транзистором, при температуре окружающей среды плюс 70°C

75 мвт.

При повышении температуры допустимая мощность снижается по линейному закону.

Напряжение коллектор-эмиттер при отсутствии запирающего смещения

минус 15 в.

При отсутствии запирающего смещения сопротивление в цепи база-эмиттер не должно превышать 2 ком.

Ток коллектора в режиме переключения или в импульсном режиме

300 ма.

Значение V_{ce} не нормируется.

Среднее значение тока эмиттера в импульсном режиме

50 ма.

Диапазон температур окружающей среды от минус 60°C до плюс 70°C.

В случае выхода транзистора из строя заполните следующие данные и отошлите поставщику:

Дата получения 196 г.

Дата установки 196 г.

Дата снятия 196 г.

Число часов работы _____

Краткая характеристика схемы использования _____

Причины снятия _____

Наименование и адрес потребителя _____

Дата заполнения 196 г.

Указания по эксплуатации транзисторов

1. При включении транзисторов в электрические цепи, находящиеся под напряжением, базовый вывод необходимо присоединять в схему первым и отключать последним. Работа транзисторов в режиме обрванной базы категорически запрещается.

2. Не рекомендуется располагать транзисторы вблизи нагреваемых элементов схемы.

3. Перед пайкой необходимо производить протирание выводов спиртом. При пайке паяльником должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора. Пайку следует производить паяльником мощностью не более 30 вт в течение времени не более 5 сек. Пайку погружением следует производить в течение времени не более 5 сек окунанием в расплавленный припой с температурой не выше 285°C + 10°C. Минимальное расстояние от корпуса транзистора до места пайки выводов при монтаже 5 мм.

4. Минимальное расстояние от корпуса транзистора до места перегиба выводов при монтаже 3 мм.

5. Рекомендуется эксплуатировать транзисторы в диапазоне температур от минус 50°C до плюс 60°C при мощности рассеивания не более 0,7 P макс, напряжении коллектора не более 0,7 Uк макс, при токе коллектора не более 0,9 Iк макс, где: P макс, Uк макс, Iк макс.—максимально-допустимые значения мощности, напряжения и тока для данной температуры.

6. Не рекомендуется использование транзисторов при совмещении двух предельно-допустимых воздействий.

Подпись заполнившего _____